









	<h2>SI7450DP-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7450DP-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 3.2A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI7450DP-T1-GE3.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3483 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI7450DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 3.2A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3483 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 3.2A (Ta) 1.9W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	80 mOhm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	42nC @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7450DP-T1-GE3TR

SI7450DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7450DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7450DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7450DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI7450DP-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 200V 3.2A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7452DP-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 11.5A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7450DP.</b> VIS SI7450DP. VIS</p>	 <p><b>SI7450DP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 3.2A PPAK SO-8</p>
 <p><b>SI7452DP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 11.5A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7450DP-T1-RE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay N-CHANNEL 200-V (D-S) MOSFET</p>	 <p><b>SI7451DP-T1</b> Vishay Precision Group SI7451DP-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI7450DP</b> SI SI7450DP SI</p>

### heiße Teile

Mehr

SI7445DP-T1-GE3	SI7446BDP	SI7446BDP-T1-E3	SI7446BDP-T1-E3	SI7446BDP-T1-GE3
SI7446BDP-T1-GE3	SI7446BDP-T1-T3	SI7446DP	SI7446DP-T1	SI7446DP-T1-GE3
SI7446DP-T1.	SI7447ADP	SI7447ADP-T1-E3	SI7447ADP-T1-E3	SI7447ADP-T1-GE3
SI7447ADP-T1-GE3	SI7447DP-T1-GE3	SI7448DP	SI7448DP-T1-E3	SI7448DP-T1-E3
SI7448DP-T1-GE3	SI7448DP-T1-GE3	SI7450DP	SI7450DP-T1-E3	SI7450DP-T1-E3
SI7450DP-T1-GE3	SI7452DP-T1-E3	SI7452DP-T1-E3	SI7452DP-T1-GE3	SI7452DP-T1-GE3
SI7454CDP-T1-GE3	SI7454CDP-T1-GE3	SI7454DDP-T1-GE3	SI7454DDP-T1-GE3	SI7454DP
SI7454DP-T1-E3	SI7454DP-T1-E3	SI7454DP-T1-GE3	SI7454DP-T1-GE3	SI7456CDP-T1-GE3
SI7456CDP-T1-GE3	SI7456DDP-T1-GE3	SI7456DDP-T1-GE3	SI7456DP	SI7456DP-T1-E3
SI7456DP-T1-E3	SI7456DP-T1-GE3	SI7456DP-T1-GE3	SI7458DP-T1-E3	SI7459DP-T1-E3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited